Національний авіаційний університет

Затверджую	
Керівник роботи	
Андреєв О. В.	
" "	

РОБОТА ТРАНЗИСТОРА З НАВАНТАЖЕННЯМ

НАУ 16 2100002 ПЗ

ВСТУП

Транзистор — напівпровідниковий елемент електронної техніки, що дозволяє керувати струмом, що протікає через нього, за допомогою зміни вхідної напруги або струму, поданих на базу, або інший електрод. Невелика зміна вхідних величин може призводити до суттєво більшої зміни вихідної напруги та струму.

Дана курсова робота виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та навичок в області біполярних транзисторів. Транзистори є основними елементами сучасної електроніки. Тому під час виконання курсової роботи слід побудувати пряму навантаження на вольт-амперній характеристиці для заданого типу транзистора та режиму; вибрати робочу точку та визначити графоаналітичним методом h-параметри, коефіцієнт підсилення та значення зворотного струму колектора $I_{\rm K3}$ для заданої температури.

					НАУ 16 2100002 ПЗ					
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата						
Розр	обив	Клокун В. Д.				Лит.	Аркуш	Аркушів		
Пер	евірив				Робота транзистора з		2	11		
					1 обота транзастора з					
Н. к	онтр.				навантаженням					
3am	вердив									

1 ДОВІДКОВІ ДАНІ ТРАНЗИСТОРА

1.1 Загальні відомості

КТ104А, КТ104Б, КТ104В, КТ104Г — це кремнієві планарно-епітаксіальні p-n-p-транзистори, призначені для роботи в схемах радіомовних приймачів та іншій апаратурі.

Корпус металевий, герметичний, з гнучкими виводами. Маса транзистора не більше $0.5\,\Gamma$.

1.2 Електричні параметри

Електричні параметри транзистора КТ104А наведені у таблиці 1.

Табл. 1 – Електричні параметри транзистора КТ104А

Найменування	Позн.	Значення		Значення Режим виміру				
		Мін.	Макс.	U_{K} , B	$U_{\rm E}$, B	$I_{ m K}$, м ${ m A}$	$I_{\rm B}$, м ${ m A}$	$I_{\rm E}$, м ${ m A}$
Зворотний струм колектора, мкА	$I_{ m K53}$		1	30				
при $T_{\rm C}=100{}^{\circ}{\rm C}$			15	20				
при $T_{\rm C} = -60{}^{\circ}{\rm C}$			1	30				
Зворотний струм емітера, мкА	$I_{ m EB3}$		1		10			
при $T_{\rm C} = 100{}^{\circ}{\rm C}$			10		5			
при $T_{\rm C} = -60{}^{\circ}{\rm C}$			1		10			

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

Табл. 1 – Електричні параметри транзистора КТ104А

Найменування	Позн.	вн. Значення Режи			жим вик	міру		
		Мін.	Макс.	U_{K} , B	$U_{\rm E}$, B	$I_{ m K}$, м ${ m A}$	$I_{\rm B}$, м ${ m A}$	$I_{\rm E}$, м ${ m A}$
Гранична напруга транзистора ($T_{\rm C} = -60 \dots + 100 ^{\circ}{\rm C}$), В	$U_{ m KE3rp}$	30						5
Напруга насичення колектор — емітер, В	$U_{ m KE}$ нас		0,5			10	2	
Напруга насичення база — емітер, В	<i>U</i> БЕнас		1			10	2	
Вхідний опір транзистора в режимі малого сигналу, Ом	h_{116}	120		30				1
Коефіцієнт передачі струму в режимі малого сигналу у схемі з ЗЕ	h _{21e}	9	36	5				1
при $T_{\rm C} = 100{}^{\circ}{\rm C}$		9	80	5				1
при $T_{\rm C} = -60{}^{\circ}{\rm C}$		6	36	5				1
Гранична частота коефіцієнта передачі струму, МГц	fh_{216}	5		5				1

			·	
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

Табл. 1 – Електричні параметри транзистора КТ104А

Найменування	Позн.	Знач	чення	Режим виміру				
		Мін.	Макс.	$U_{ m K},{ m B}$	$U_{\rm E}$, B	I_{K} , mA	I_{B} , MA	I_{E} , MA
ϵ Киність колекторного переходу (при $f = 465 \mathrm{k}\Gamma$ ц), п Φ	$C_{ m K}$		50	5				
ϵ Смність емітерного переходу (при $f = 465 \mathrm{k}\Gamma\mathrm{ц}$), п Φ	$C_{ m E}$		10		0,5			
Стала часу ланцюгу зворотного зв'язку на високій частоті (при $f = 3 \mathrm{M}\Gamma\mathrm{u}$), нс	$ au_{ m K}$		3	5				1

1.3 Максимально допустимі параметри

Максимально допустимі параметри для транзистора КТ140A наведені у таблиці 2.

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

Табл. 2 – Максимально допустимі параметри для транзистора КТ104А

Найменування	Позначення	Значення
Постійний струм колектора, мА	$I_{ m K\ max}$	50
Постійна напруга колектора, В	$U_{ m KE\ max}$	30
Постійна напруга колектор — емітер (при запираючій напрузі $U_{\rm EB}=0.5~{\rm B}$ або при $R_{\rm E}\leqslant 10~{\rm кOm}$), В	$U_{ m KE\;max}$	30
Постійна напруга емітер — база, В	U _{EБ max}	10
Постійна розсіювана потужність колектора, мВт	$P_{ m K\;max}$	150
Тепловий опір перехід — середовище, °С/мВт	R _{т, п—с}	0,4
Допустима температура навколишнього середовища, °С		-60100

2 ВОЛЬТ-АМПЕРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРА

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

3	ПОБУДОВА ПРЯМОЇ НАВАНТАЖЕННЯ	
3м. Лист №	НАУ 16 2100002 ПЗ докум. Підп. Дата	Аркуі 8

4	1]	ГРАФІЧ	не визн	ІАЧЕННЯ К	K_U, K_I, K_P	
			T I			Аркуш
3м. <i>Лист</i>	№ дон	сум. Підп.	Дата	НАУ 16 210	0002 ПЗ	<i>Аркуш</i> 9

		5	ВИ З		4EH	І КН	IAPA	MET	TPIB	H_{11}	$,H_{1}$	₂ , H	219	
Зм.	Лист	<u>No</u> (докум.	Підп.	Дата		HAS	V 16 2	21000)02 I	73		A	1ркуш 10

3MICT

Вступ						
1	Дов	ідкові дані транзистора	3			
	1.1	Загальні відомості	3			
	1.2	Електричні параметри	3			
	1.3	Максимально допустимі параметри	5			
2	Вол	ьт-амперні характеристики транзистора	7			
3	Поб	удова прямої навантаження	8			
4	Гра	фічне визначення K_U, K_I, K_P	9			
5	5 Визначення параметрів $h_{11}, h_{12}, h_{21}, h_{22}$.					

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата